

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010948183 **Image available**

WPI Acc No: 1996-445133/199645

XRAM Acc No: C96-140118

XPX Acc No: N96-374832

**Mfr. of electron-emitting device - by applying material contg. metal cpd.
and film thickness controlling agent onto substrate**

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: MIURA N; TAKAHASHI Y

Number of Countries: 008 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 736892	A1	19961009	EP 96302284	A	19960329	199645 B
JP 8273533	A	19961018	JP 9599497	A	19950403	199701
JP 9102271	A	19970415	JP 95284377	A	19951006	199725
CN 1138210	A	19961218	CN 96101935	A	19960403	199806
KR 221294	B1	19990915	KR 969965	A	19960403	200107

Priority Applications (No Type Date): JP 95284377 A 19951006; JP 9599497 A 19950403

Cited Patents: EP 693766

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	--------	----------	--------------

EP 736892	A1	E 43	H01J-009/02	
Designated States (Regional): DE FR GB IT NL				
JP 8273533	A	20	H01J-009/02	
JP 9102271	A	15	H01J-009/02	
CN 1138210	A		H01J-009/02	
KR 221294	B1		H01J-031/10	

Abstract (Basic): EP 736892 A

A method for mfr. of an electron-emitting device possessing an electroconductive film, on which an electron-emission region is formed, forms an electron-emission region by a process that includes applying a metal cpd.-contg. material and a film thickness controlling agent to the substrate. Also claimed are: (1) a method for mfr. of an electron source comprising a substrate and multiple electron-emitting devices arrayed on the substrate, in which the electron-emitting devices are mfd. by the above method; and (2) a method for mfr. of an image-forming apparatus comprising a substrate with multiple electron-emitting devices as above, and an image-forming device, in which the electron-emitting devices are mfd. by the above process.

USE - Used in display panels and image-forming systems, e.g. television sets, monitors for video conferencing or computer systems, in a photo-printer comprising a photo- sensitive drum, which uses a line-form emission source or a two-dimensional emission source, etc..

ADVANTAGE - The method prevents the seepage of droplets due to the printed electrodes and non-uniform spreading of the droplets due to a distribution of wetting properties between areas of the substrate or between the substrate and the electrodes. There is no pptn. of crystals during the time interval between droplet deposition and baking, nor is there any volatilisation or sublimation, which reduces thinning of the electroconductive film and minimises irregularities in its electrical properties, e.g. sheet resistance.

Dwg.1A/19

Title Terms: MANUFACTURE; ELECTRON; EMIT; DEVICE; APPLY; MATERIAL; CONTAIN; METAL; COMPOUND; FILM; THICK; CONTROL; AGENT; SUBSTRATE

Derwent Class: A85; G08; L03; V05

International Patent Class (Main): H01J-009/02; H01J-031/10

International Patent Class (Additional): G09F-009/313; H01J-001/30;

H01J-009/00; H01J-029/46; H01J-031/12; H04N-005/335

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): A12-E11A; A12-L05C1; G02-A05B; G05-F; G06-A07;

G06-F06; G06-F07; L03-C02; L03-G05

Manual Codes (EPI/S-X): V05-L01A3; V05-L05D1

Polymer Indexing (PS):

<01>

001 018; R00446 G0282 G0271 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D60
D83 F36 F35; H0000; H0011-R; P0088 ; P0099

002 018; G3634-R D01 D03 D11 D10 D23 D22 D31 D42 D76 F24 F34 H0293
P0599 G3623

003 018; R03275 R01863 D01 D11 D10 D23 D22 D31 D42 D50 D76 D86 F24 F29
F26 F34 H0293 M2313 P0599 G3623

004 018; ND01; Q9999 Q7512; Q9999 Q8606-R; Q9999 Q8775-R; N9999 N7147
N7034 N7023; Q9999 Q7114-R; B9999 B5243-R B4740; K9676-R; K9483-R

<02>

001 018; R01860 G3678 G3634 D01 D03 D11 D10 D23 D22 D31 D42 D50 D76 D89
F24 F34 H0293 P0599 G3623; S9999 S1616 S1605

002 018; ND01; Q9999 Q7512; Q9999 Q8606-R; Q9999 Q8775-R; N9999 N7147
N7034 N7023; Q9999 Q7114-R; B9999 B5243-R B4740; K9676-R; K9483-R;
B9999 B3678 B3554

Derwent Registry Numbers: 0246-U; 0247-U; 1544-U

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-102271

(43) 公開日 平成9年(1997)4月15日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 J	9/02		H 0 1 J	9/02
	1/30			1/30
	31/12			31/12
				B
				B
				C

審査請求 未請求 請求項の数8 F D (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願平7-284377

(22) 出願日 平成7年(1995)10月6日

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 三浦 直子

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ
ン株式会社内

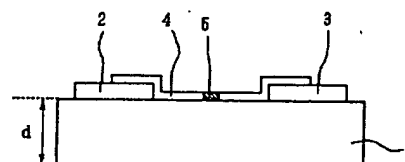
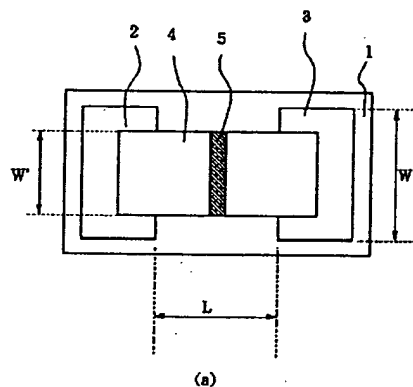
(74) 代理人 弁理士 伊東 哲也 (外1名)

(54) 【発明の名称】 電子放出素子の製造方法、電子放出素子、表示素子および画像形成装置

(57) 【要約】

【課題】 従来技術における表面伝導型電子放出素子の製造方法において、予め電極部及びその周囲に、加熱により粘性を増す水溶液の液滴を付与することにより、特性を改善した電子放出素子、表示素子、画像形成装置を提供する。

【解決手段】 基板上に設けられた対向する電極間に電子放出材料を含む金属化合物水溶液の液滴を部分的に付与する工程と、加熱焼成工程と、通電処理する過程を経て電子放出部を形成する工程とを有する電子放出素子の製造方法において、前記金属化合物を含む水溶液の液滴を基板に部分的に付与する工程に先立ち、前記水溶液が付与される電極部に、水溶性樹脂を含む水溶液の液滴を付与し、加熱する工程を有することを特徴とする電子放出素子製造方法。



(b)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に設けられた対向する電極間に電子放出材料を含む金属化合物水溶液の液滴を部分的に付与する工程と、加熱焼成工程と、通電処理する過程を経て電子放出部を形成する工程とを有する電子放出素子の製造方法において、前記金属化合物を含む水溶液の液滴を基板に部分的に付与する工程に先立ち、前記水溶液が付与される電極部に、水溶性樹脂を含む水溶液の液滴を付与、加熱する工程を有することを特徴とする電子放出素子の製造方法。

【請求項2】 請求項1において電極がオフセット印刷法により作製されたことを特徴とする電子放出素子の製造方法。

【請求項3】 請求項2において水溶性樹脂は、請求項1の金属組成物の焼成温度以下の温度で分解し、分解後基板には残渣が残らないことを特徴とする電子放出素子の製造方法。

【請求項4】 請求項1において、2種の液滴付与手段がインクジェット方式であることを特徴とする電子放出素子の製造方法。

【請求項5】 請求項6においてインクジェット方式がバブルジェット方式であることを特徴とする電子放出素子の製造方法。

【請求項6】 請求項1ないし7項記載の製造方法に従い製造されたことを特徴とする電子放出素子。

【請求項7】 電子放出素子と該電子放出素子から放出される電子線の照射により発光する発光体とからなる表示素子において、請求項8に記載の電子放出素子を用いたことを特徴とする表示素子。

【請求項8】 対向する電極間に設けた電子放出材料に電圧を印加して電子放出させる電子放出素子および蛍光板との間に高電圧を印加して加速した電子を蛍光板に衝突させて画像を表示する画像形成装置において、請求項8に記載の電子放出素子を用いたことを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は電子放出素子の製造方法に関し、更に詳しくはインクジェット方式を利用して形成した電子放出素子の製造方法、該電子放出素子を用いた表示素子および画像形成装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、電子放出素子としては熱電子源と冷陰極電子源の2種類が知られている。冷陰極電子源には電界放出型素子（以下FE型素子と略す）、金属/絶縁層/金属型素子（以下MIM素子と略す）、表面伝導型電子放出素子（以下SCE素子と略す）等がある。

【0003】 FE型素子の報告例としてはW.P. Dyke & W.W. Dolan, "Field emission", Advance in Electron Physics, 8, 89(1956)や "Physical properties of t

hin-film field emission cathodes with molybdenum cations", J. Appl. Phys., 47, 5248(1976)等が知られている。MIM素子の報告例としてはC.A. Mead, "Thetunnel-emission amplifier" A. Appl. Phys., 32, 646(1961)等が知られている。SCE素子の報告例としてはM. I. Elinson, Radio Eng. Electron Phys., 10, (1965)等がある。

【0004】 SCE素子は基板上に形成された小面積の薄膜に、膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が起こる現象を利用するものである。この表面伝導型電子放出素子としては前記エリンソン等による SnO_2 薄膜を用いたもののほか、Au薄膜を用いたもの[G. Dittmer: "Thin Solid Films", 9, 317(1972)]、 $\text{In}_2\text{O}_3/\text{SnO}_2$ 薄膜を用いたもの[M. Hartwell and C.G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.", 519(1975)]、カーボン薄膜を用いたもの[荒木久 他: 真空、第26巻、第1号、22頁(1983)]等が報告されている。

【0005】 これらの表面伝導型電子放出素子の典型的な素子構成として前述のM. ハートウェルの素子構成を図13により説明する。同図において1は絶縁性基板、2および3は素子に電圧を印加するための一対の素子電極、4は電子放出部を含む薄膜で、スパッタで形成された金属酸化物薄膜等からなり、後述の通電フォーミングと呼ばれる通電処理により電子放出部5が形成される。尚、図中の素子電極間隔Lは、0.5mm~1mm、素子の幅W'は約0.1mmで設定されている。Wは素子電極の幅、dは素子電極の厚さを表している。また、電子放出部5の位置及び形状については模式図とした。

【0006】 従来、これらの表面伝導型電子放出素子においては、電子放出を行う前に電子放出部形成用薄膜を予めフォーミングと呼ばれる通電処理によって電子放出部5を形成するのが一般的であった。即ち、フォーミングとは前記電子放出部形成用薄膜の両端に電極2、3を用いて電圧を印加通電し、電子放出部形成用薄膜を局所的に破壊、変形もしくは変質させることにより、電気的に高抵抗な状態の電子放出部5を形成することである。なお、フォーミングにより電子放出部形成用薄膜の一部に亀裂が発生しその亀裂付近から電子放出が行われ電子放出部5となる場合もある。

【0007】 前記のフォーミング処理をした表面伝導型電子放出素子は、上述の電子放出部を含む薄膜4に電圧を印加して素子表面に電流を流すことにより、上述の電子放出部5より電子を放出するものである。

【0008】 上述したような電子放出素子の製造技術には、従来半導体プロセスに準じたフォトリソグラフ技術が利用されてきた。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】 上述の表面伝導型電子放出素子は、大面積基板に多数配列形成することにより画像形成装置などへの応用が可能であるが、従来のフォ

トリソグラフ技術を用いた製造方法では莫大な費用がかかることから、より低コストな製造方法を用いることが必要であった。そこで、大面積基板に素子を形成する方法として電極2、3の形成に印刷技術を用い、電子放出薄膜4の形成にはインクジェット方式により有機金属化合物を含む溶液の液滴を基板に部分的に付与する方法が提供された。

【0010】印刷技術およびインクジェット方式を用いた場合の電子放出素子の製造工程の概略を図3に基づいて説明する。

1) 絶縁性基板1を洗剤、純水および有機溶剤により十分に洗浄後、スクリーン印刷技術あるいはオフセット印刷技術によって、前記絶縁性基板1の面上に素子電極2、3を形成する(図3(a))。

2) 絶縁性基板の素子電極2と3のギャップ部分に、両電極にまたがるように、例えば、ジメチルスルホキシドと有機金属化合物とを含む水溶液の液滴を液滴付与手段21を用いて付与する。この基板を乾燥、焼成して電子放出部形成用薄膜4を形成する(図3(d))。

【0011】しかしながら印刷電極上にインクジェット方式で液滴を付与する場合、以下のような問題があった。

【0012】すなわち印刷電極の密度が低い場合、付与された液滴が毛細管現象により電極内に浸透するという現象が起こることがあった。それによりギャップ部分では液の量、広がりが不均一になり、焼成後の電子放出膜の膜厚不均一、素子による膜厚のばらつきや電気特性のばらつきを生じる原因となっていた。

【0013】

【発明の目的】本発明の目的は、このような従来技術の欠点を改善するものであり、インクジェット方式で電子放出膜を製造する方法において、金属化合物を含む水溶液の液滴をギャップ部分に付与する工程に先立ち、前記水溶液が付与される電極部およびその周囲の電極部に、水溶性樹脂を含む水溶液の液滴を付与、加熱する工程を行い、前記金属化合物を含む水溶液の電極内への浸透を防ぎ、得られる膜厚や素子特性のばらつきの少ない電子放出素子およびこれらを用いた画像形成装置の製造方法を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】本発明の電子放出素子の製造方法は、基板上に設けられた対向する電極間に電子放出材料を含む金属化合物溶液の液滴を部分的に付与する工程と、加熱焼成工程と、通電処理する過程を経て電子放出部を形成する工程とを有する電子放出素子の製造方法において、前記金属化合物溶液を含む水溶液の液滴を基板に部分的に付与する工程に先立ち、前記水溶液が付与される電極部及びその周囲に、水溶性樹脂を含む水溶液の液滴を付与、加熱する工程を有することを特徴とするものである。

【0015】さらに本発明の別の態様は、このような電子放出素子の製造方法により形成された電子放出素子およびそれを用いたことを特徴とする表示素子、画像形成装置に関するものである。

【0016】以下、本発明による電子放出素子の製造方法について説明する。

【0017】本発明で用いられる前記「水溶性樹脂を含む水溶液」の組成、特徴について説明する。

【0018】本発明で用いられる水溶液には水溶性樹脂が含まれることを特徴としており、加熱に伴って起こる溶媒の蒸発あるいは水溶性樹脂の重合反応により、水溶液の粘度が増加する。基板に液滴を付与する際の初期粘度は2~10センチポイズが望ましい。これはインクジェット方式により水溶液の液滴を基板に付与する際の望ましい粘度である。加熱後の粘度は数100センチポイズ以上が望まれる。

【0019】その他水性樹脂に望まれる条件として以下の点が挙げられる。

①加熱により粘性を増した水溶液は、その後再度室温まで冷却された場合にもその粘性を失わない。

②加熱により粘性を増した水溶液中の水性樹脂は、有機金属化合物の焼成温度以下の温度で分解し、分解後基板上には残渣が残らない。したがってカリウム、ナトリウムを始めとする金属元素を含む金属塩類は用いることができない。

【0020】以上の条件を満たす水性樹脂の例としては、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、デキストリン、アクリル酸、メタクリル酸、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール等が挙げられる。次に本発明の主眼である前述の加熱による粘性を増す水溶液の組成及びその付与方法について図3を用いて説明する。

【0021】上記水溶液を基板に付与する手段は、液滴を形成し付与することが可能ならば任意の方法でよいが、特に微小な液滴を効率よく適度な精度で発生付与でき制御性も良好なインクジェット方式が便利である。これは10ナノグラム程度から数10マイクログラム程度までの微小液滴を再現性良く任意の位置に付与することができるという理由から最も良好な方法である。付与は電極上の一部に行なう。付与する箇所は有機金属化合物を含む水溶液が付与される箇所及びその周囲およそ数10 μ mの範囲である。付与された水溶液は電極内に浸透し、その後加熱されることにより粘性が増加し電極内の隙間に保持され、隙間を埋めた状態になる。加熱温度は200℃以下が望ましい。加熱後再び基板を冷却し、有機金属化合物を含む水溶液を付与する。付与された水溶液は電極内に浸透することなく電極上及び電極ギャップ内の所定の位置に定着する。さらに焼成工程を経て一定の膜厚の電子放出膜が作製される。

【0022】本発明で用いられる前記の金属化合物の金

属元素としては、パラジウム、白金、ルテニウム、金、チタン、インジウム、銅、クロム、鉄、亜鉛、錫、タンタル、タングステン、鉛等を用いることができる。該金属化合物の焼成は焼成温度300~350℃、保持時間10~12分で行われることが好ましい。

【0023】電子放出部導電膜の形成のために基板に付与される液体は、上記の有機金属化合物とジメチルスルホキシドを含む水溶液である。適当なジメチルスルホキシドの濃度の範囲は重量で0.005%から70%である。ジメチルスルホキシドを上記有機金属化合物とともに水に溶解すると、ジメチルスルホキシドを加えない場合よりも有機金属化合物の溶解性が向上することと、基板面に付与された溶液の液滴の付着安定性が向上する。0.005%以下では添加の効果がほとんど確認できない。70%以上では基板上に付与された液滴の乾燥が遅く、工程上の取り扱いが面倒になる。

【0024】次に、本発明の製造方法により形成される表面伝導型電子放出素子の基本的な構成としては、平面型及び垂直型の2つの構成が上げられる。

【0025】まず、表面伝導型電子放出素子の構成について説明する。

【0026】図1はそれぞれ本発明に好適な基本的な表面伝導型電子放出素子の基本的な構成を示す模式的平面図である。図1を用いて本発明に好適な基本的な表面伝導型電子放出素子の基本的な構成を説明する。

【0027】図1において、1は絶縁性基板、2、3は素子電極、4は導電性薄膜、5は電子放出部である。絶縁性基板1としては、石英ガラス、Naなどの不純物含有量を減少したガラス、青板ガラス、青板ガラスにスパッタ法等により形成した SiO_2 を積層したガラス基板等及びアルミナ等のセラミックス等が用いられる。

【0028】素子電極間隔(L)及び素子電極長さ(W)の形状等は、応用される形態等によって適宜設計される。

【0029】素子電極間隔(L)は、好ましくは、数百オングストロームより数百マイクロメートルであり、より好ましくは、素子電極間に印加する電圧等により、数マイクロメートルより数十マイクロメートルである。

【0030】素子電極長さ(W)は、好ましくは、電極の抵抗値、電子放出特性により、数マイクロメートルより数百マイクロメートルであり、また素子電極2、3の膜厚dは、数百オングストロームより数マイクロメートルである。

【0031】尚、図1の構成だけでなく、絶縁性基板1の上に、導電性薄膜4、対向する素子電極2、3の順に積層構成としてもよい。

【0032】導電性薄膜4は、良好な電子放出特性を得るためには微粒子で構成された微粒子膜が特に好ましく、その膜厚は素子電極2、3へのステップカバレッジ、素子電極2、3間の抵抗値及び後述する通電フォー

ミング条件等によって、適宜設定され、好ましくは数オングストロームより数千オングストロームで、特に好ましくは10オングストロームより500オングストロームであり、その抵抗値は、10の3乗から10の7乗オーム/□のシート抵抗値である。

【0033】前記電子放出部5は、導電性薄膜4の一部に形成される高抵抗の亀裂であり、導電性薄膜4の膜厚、膜質、材料及び後述する通電フォーミングなどの製法に依存して形成される。また、数オングストロームより数百オングストロームの粒径の導電性微粒子を有することもある。この導電性微粒子は、導電性薄膜4を形成する材料の元素の一部、あるいは全てと同様のものである。また、電子放出部5及びその近傍の導電性薄膜4には、炭素及び炭素化合物を有することもある。

【0034】次に本発明に好適な別な構成の表面伝導型電子放出素子である垂直型表面伝導型電子放出素子について説明する。

【0035】図2は、本発明に好適な基本的な垂直型表面伝導型電子放出素子の構成を示す模式的図面である。図2において、図1と同一の符号のものは同一である。21は段差形成部である。基板1、素子電極2、3、導電性薄膜4、電子放出部5は前述した平面型表面伝導型電子放出素子と同様の材料で構成されたものであり、段差形成部21は、真空蒸着法、印刷法、スパッタ法等で形成された SiO_2 等の絶縁性材料で構成され、段差形成部21の膜厚が先に述べた平面型表面伝導型電子放出素子の素子電極間隔Lに対応し、数百オングストロームより数十マイクロメートルであり、段差形成部の製法及び素子電極間に印加する電圧等により設定されるが、好ましくは数百オングストロームより数十マイクロメートルである。

【0036】導電性薄膜4は、素子電極2、3と段差形成部21を作成後に形成するため、素子電極2、3の上に積層される。なお、電子放出部5は、図2において、段差形成部21に直線状に示されているが、作成条件、通電フォーミング条件などに依存し、形状、位置ともこれに限るものではない。

【0037】上述の表面伝導型電子放出素子の製造方法としては様々な方法が考えられるが、その一例を図3に示す。

【0038】以下、順をおって電子放出素子の製造方法の概略を図1及び図3に基づいて説明する。図1と同一の符号のものは同一の部材を示す。

【0039】図1は本発明の方法により製造された電子放出素子の一例を示す概略図、図3は本発明の電子放出素子の製造方法の一例を示す工程図である。

1) 絶縁性基板1を洗剤、純水および有機溶剤により十分に洗浄後、オフセット印刷技術によって、前記絶縁性基板1の面上に素子電極2、3を形成する(図3(a))。

2) 水溶性樹脂を含む水溶液の液滴を、インクジェット方式を用いて電極の一部に付与する(不図示)。付与する位置は金属化合物を含む水溶液が付与される箇所およびその周囲およそ $10\mu\text{m}$ の範囲である。

3) 2)で付与した液が粘性を増す温度まで基板を加熱する。

4) 絶縁性基板の素子電極2と3のギャップ部分に、両電極にまたがるように、ジメチルスルホキシドと金属化合物を含む水溶液の液滴をインクジェット方式(不図示)を用いて付与する。この時電極上では2)の水溶液を付与した領域を越えない領域に付与する。

5) この基板を乾燥、焼成して電子放出部形成用薄膜4を形成する(図3(c))。なお焼成により3)の粘性溶液は蒸発および分解し、分解後基板上には残渣は残らない。

6) つづいて、真空容器中においてフォーミングと呼ばれる通電処理を行なう。素子電極2、3間に電圧を不図示の電源によりパルス状あるいは、高速の昇電圧による通電処理がおこなわれると、電子放出部形成用薄膜4の部位に構造の変化した電子放出部5が形成される(図3(d))。この電子放出部5は電子放出部形成用薄膜4が前記の通電処理により局所的に破壊、変形もしくは変質し、構造の変化した部位である。先に説明したように、電子放出部5は導電性微粒子で構成されていることを本出願人らは観察している。

【0040】フォーミング処理の電圧波形を図4に示す。図4中、T1及びT2は電圧波形のパルス幅とパルス間隔であり、T1を1マイクロ秒～10ミリ秒、T2を10マイクロ秒～100ミリ秒とし、三角波の波高値(フォーミング時のピーク電圧)は4V～10V程度である。フォーミング処理は真空雰囲気下で素子の電極間に前記の電圧波形を数十秒間程度適宜印加して行なった。

【0041】以上の説明では電子放出部の形成のために、素子の電極間に三角波パルスを印加してフォーミング処理を行なっているが、素子の電極間に印加する波形は三角波に限定することなく、矩形波など所望の波形を用いても良く、その波高値及びパルス幅、パルス間隔等についても上述の値に限ることなく、電子放出部が良好に形成されれば所望の値を選択することができる。

7) つづいて上記フォーミング行なった素子に、活性化と呼ばれる処理を行なうことが望ましい。ここに言う活性化は、適当な真空度、例えば 10^{-4} ～ 10^{-5} torrの真空度のもとに前記のフォーミングと同様のパルス電圧を素子に繰り返し印加する処理のことである。活性化処理は希薄に存在する有機化合物に由来する炭素あるいは炭素化合物を電子放出部形成用薄膜上に堆積させ、電子放出素子の素子電流If、放出電流Ieを著しく変化させる。活性化は、例えば放出電流Ieがほぼ飽和に達した時点で終了させればよい。

【0042】上述のような素子構成と製造方法によって作成された本発明に係る電子放出素子の基本特性について図5、図6を用いて説明する。

【0043】図5は、図1で示した構成を有する素子の電子放出特性を測定するための測定評価装置の概略構成図である。電子放出素子の素子電流If、放出電流Ieの測定にあたっては、素子電極2、3に電源31と電流計30とを接続し、該電子放出素子の上方に電源33と電流計32とを接続したアノード電極34を配置している。図5において、1は絶縁性基体、2および3は素子電極、4は電子放出部を含む薄膜、5は電子放出部を示す。また、51は素子に素子電圧Vfを印加するための電源、50は素子電極2、3間の電子放出部を含む薄膜4を流れる素子電流Ifを測定するための電流計、54は素子の電子放出部より放出される放出電流Ieを捕捉するためのアノード電極、53はアノード電極54に電圧を印加するための高圧電源、52は素子の電子放出部5より放出される放出電流Ieを測定するための電流計である。

【0044】また、本電子放出素子およびアノード電極54は真空装置内に設置され、その真空装置には不図示の排気ポンプおよび真空計等の真空装置に必要な機器が具備されており、所望の真空中で本素子の測定評価を行えるようになっている。なお、アノード電極の電圧は1kV～10kV、アノード電極と電子放出素子との距離Hは3mm～8mmの範囲で測定した。

【0045】更に、本発明者は、上述の本発明に係わる表面伝導型電子放出素子の特性を鋭意検討した結果、本発明の原理となる特性上の特徴を見いだした。図5に示した測定評価装置により測定された放出電流Ieおよび素子電流Ifと素子電圧Vfの関係の典型的な例を図6に示す。なお、放出電流Ieと素子電流Ifは大きさが著しく異なる。図6ではIf、Ieの変化の定性的比較のためにリニアスケールで任意単位で表記した。

【0046】本電子放出素子は放出電流Ieに対する三つの特徴を有する。まず第一に、図6からも明らかなように、本素子はある電圧(しきい値電圧と呼ぶ、図6中のVth)以上の素子電圧を印加すると急激に放出電流Ieが増加し、一方しきい値電圧Vth以下では放出電流Ieがほとんど検出されない。すなわち、放出電流Ieに対する明確なしきい値電圧Vthを持った非線形素子である。第二に、放出電流Ieが素子電圧Vfに依存するため、放出電流Ieは素子電圧Vfで制御できる。第三に、アノード電極54に捕捉される放出電荷は、素子電圧Vfを印加する時間に依存する。すなわち、アノード電極54に捕捉される電荷量は、素子電圧Vfを印加する時間により制御できる。以上のような特性を有するため、本発明にかかわる電子放出素子は、多方面への応用が期待できる。

【0047】また、素子電流Ifが素子電圧Vfに対し

て単調増加する特性(MI特性と呼ぶ)の例を図6に示したが、この他にも素子電流 I_f が素子電圧 V_f に対して電圧制御型負性抵抗特性(VCNR特性と呼ぶ)を示す場合もある(不図示)。なおこの場合も、本電子放出素子は上述した三つの特性上の特徴を有する。

【0048】なお、以上表面伝導型電子放出素子の基本的な構成、製法について述べたが、本発明の思想によれば、表面伝導型電子放出素子の特性で前記の3つの特徴を有すれば、上述の構成等に限定されず、後述の電子源、表示装置等の画像形成装置に於ても利用できる。

【0049】次に、本発明に好適な電子源及び画像形成装置について述べる。本発明に好適な表面伝導型電子放出素子を複数個、基板上に配列し、電子源あるいは画像形成装置が構成できる。

【0050】基板上の配列の方式には、例えば、従来例で述べた多数の表面伝導型電子放出素子を並列に配置し、個々の素子の両端を配線で接続し、電子放出素子の行を多数配列し(行方向と呼ぶ)、この配線と直交する方向に(列方向と呼ぶ)、該電子源の上方の空間に設置された制御電極(グリッドとも呼ぶ)により、電子放出素子からの電子を制御駆動するはしご状配置や、次に述べる m 本の X 方向配線の上に n 本の Y 方向配線を層間絶縁を介して設置し、表面伝導型電子放出素子の一对の電子電極にそれぞれ X 方向配線、 Y 方向配線を接続した配置法が上げられる。これを単純マトリクス配置と以降呼ぶ。まず、単純マトリクス配置について詳述する。

【0051】前述した本発明にかかわる表面伝導型電子放出素子の基本的特性の3つの特徴によれば、単純マトリクス配置された表面伝導型電子放出素子においても、表面伝導型電子放出素子からの放出電子は、しきい値電圧以上では対向する素子電極間に印加するパルス状電圧の波高値と巾に制御される。一方、しきい値電圧以下においては電子は殆ど放出されない。この特性によれば、多数の電子放出素子を配置した場合においても、個々の素子に上記パルス状電圧を適宜印加すれば、任意の表面伝導型電子放出素子を選択することができ、その電子放出量を制御できることとなる。

【0052】以下この原理に基づき構成した電子源基板の構成について図7を用いて説明する。図7において71は電子源基板、72は X 方向配線、73は Y 方向配線、74は表面伝導型電子放出素子、75は結線である。なお表面伝導型電子放出素子74は前述した平面型あるいは垂直型どちらであってもよい。

【0053】同図において、電子源基板71は前述したガラス基板等であり、その大きさおよびその厚みは電子源基板71に設置される表面伝導型素子の個数および個々の素子の設計上の形状、および電子源の使用時容器の一部を構成する場合には、その容器を真空中に保持するための条件等に依存して適宜設定される。

【0054】 m 本の X 方向配線72は $DX1$ 、 $DX2$ 、

・・・ DXm からなり、電子源基板71上に真空蒸着法、印刷法、スパッタ法等で形成した導電性金属等である。また、多数の表面伝導型素子にほぼ均等な電圧が供給されるように材料、膜厚、配線巾等が適宜設定される。 Y 方向配線73は $DY1$ 、 $DY2$ 、・・・ DYn の n 本の配線よりなり、 X 方向配線72と同様に作成される。これら m 本の x 方向配線72と n 本の Y 方向配線73間には、不図示の層間絶縁層が設置され、電気的に分離されて、マトリクス配線を構成する。この m 、 n は、共に正の整数である。

【0055】不図示の層間絶縁層は、真空蒸着法、印刷法、スパッタ法等で形成された SiO_2 等であり X 方向配線72を形成した絶縁性基板71の全面或は一部に所望の形状で形成され、特に、 X 方向配線72と Y 方向配線73の交差部の電位差に耐え得るように、膜厚、材料、製法が適宜設定される。また、 X 方向配線72と Y 方向配線73は、それぞれ外部端子として引き出されている。

【0056】更に前述と同様にして、表面伝導型放出素子74の対向する電極(不図示)が、 m 本の X 方向配線72と n 本の Y 方向配線73と、真空蒸着法、印刷法、スパッタ法等で形成された導電性金属等からなる結線75によって電気的に接続されているものである。

【0057】ここで、 m 本の X 方向配線72と n 本の Y 方向配線73と結線75と対向する素子電極の導電性金属は、その構成元素の一部あるいは全部が同一であっても、またそれぞれ異なってもよく、前述の素子電極の材料等より適宜選択される。尚、これら素子電極への配線は、素子電極と配線材料が同一である場合は、素子電極と総称する場合もある。また表面伝導型電子放出素子は、基板71あるいは不図示の層間絶縁層上のどちらに形成してもよい。

【0058】また、詳しくは後述するが、前記 X 方向配線72には、 X 方向に配列する表面伝導型放出素子74の行を入力信号に応じて、走査するための走査信号を印加するための不図示の走査信号発生手段と電気的に接続されている。

【0059】一方、 Y 方向配線73には、 Y 方向に配列する表面伝導型放出素子74の列の各列を入力信号に応じて、変調するための変調信号を印加するための不図示の変調信号発生手段と電気的に接続されている。

【0060】更に、表面伝導型電子放出素子の各素子に印加される駆動電圧は、当該素子に印加される走査信号と変調信号の差電圧として供給されるものである。

【0061】上記構成において、単純なマトリクス配線だけで個別の素子を選択して独立に駆動可能になる。

【0062】つぎに、以上のようにして作成した単純マトリクス配置の電子源による表示等に用いる画像形成装置について、図8と図9及び図10を用いて説明する。図8は、画像形成装置の表示パネルの基本構成図であ

り、図9は蛍光膜、図10は画像形成装置をNTSC方式のテレビ信号に応じて表示を行なう例の駆動回路のブロック図である。

【0063】図8において71は、上述のようにして電子放出素子を作製した電子源基板、81は電子源基板71を固定したリアプレート、86はガラス基板83の内面に蛍光膜84とメタルバック85等が形成されたフェースプレート、82は支持枠であり、リアプレート81、支持枠82及びフェースプレート86をフリットガラス等を塗布し、大気中あるいは窒素中で、400～500度で10分以上焼成することで封着して、外囲器88を構成する。

【0064】図8において、74は図1における電子放出部に相当する。72、73は表面伝導型電子放出素子の一对の素子電極と接続されたX方向配線及びY方向配線である。

【0065】外囲器88は上述の如く、フェースプレート86、支持枠82、リアプレート81で外囲器88を構成したが、リアプレート81は主に基板71の強度を補強する目的で設けられるため、基板71自体で十分な強度を持つ場合は別体のリアプレート81は不要であり、基板71に直接支持枠82を封着し、フェースプレート86、支持枠82、基板71にて外囲器88を構成しても良い。またさらには、フェースプレート86、リアプレート81間に、スペーサーとよばれる不図示の支持体を設置することで、大気圧に対して十分な強度をもつ外囲器88の構成にすることもできる。

【0066】図9は蛍光膜である。蛍光膜84は、モノクロームの場合は蛍光体のみから成るが、カラーの蛍光膜の場合は、蛍光体の配列によりブラックストライプあるいはブラックマトリクスなどと呼ばれる黒色導電材91と蛍光体92とで構成される。ブラックストライプ、ブラックマトリクスが設けられる目的は、カラー表示の場合必要となる三原色蛍光体の、各蛍光体92間の塗り分け部を黒くすることで混色等を目立たなくすることと、蛍光膜84における外光反射によるコントラストの低下を抑制することである。ブラックストライプの材料としては、通常よく用いられている黒鉛を主成分とする材料だけでなく、導電性があり、光の透過及び反射が少ない材料であればこれに限るものではない。

【0067】ガラス基板93に蛍光体を塗布する方法はモノクローム、カラーによらず、沈殿法や印刷法が用いられる。

【0068】また、蛍光膜84の内面側には通常メタルバック85が設けられる。メタルバックの目的は、蛍光体の発光のうち内面側への光をフェースプレート86側へ鏡面反射することにより輝度を向上すること、電子ビーム加速電圧を印加するための電極として作用すること、外囲器内で発生した負イオンの衝突によるダメージからの蛍光体の保護等である。メタルバックは、蛍光膜

作製後、蛍光膜の内面側表面の平滑化処理（通常フィリミングと呼ばれる）を行い、その後A1を真空蒸着等で堆積することで作製できる。

【0069】フェースプレート86には、更に蛍光膜84の導電性を高めるため、蛍光膜84の外面側に透明電極（不図示）を設けてもよい。

【0070】前述の封着を行う際、カラーの場合は各色蛍光体と電子放出素子とを対応させなくてはならないため、十分な位置合わせを行なう必要がある。

【0071】外囲器88は不図示の排気管を通じ、10のマイナス7乗トール程度の真空中にされ、封止を行なわれる。また、外囲器88の封止後の真空中を維持するために、ゲッター処理を行なう場合もある。これは、外囲器88の封止を行なう直前あるいは封止後に、抵抗加熱あるいは高周波加熱等の加熱法により、外囲器88内の所定の位置（不図示）に配置されたゲッターを加熱し、蒸着膜を形成する処理である。ゲッターは通常Ba等が主成分であり、該蒸着膜の吸着作用により、たとえば1X10マイナス5乗ないしは1X10マイナス7乗[Torr]の真空中を維持するものである。尚、表面伝導型電子放出素子のフォーミング以降の工程は、適宜設定される。

【0072】次に、単純マトリクス配置の電子源を用いて構成した表示パネルを、NTSC方式のテレビ信号にもとづきテレビジョン表示を行なう為の駆動回路の概略構成を、図10のブロック図を用いて説明する。101は前記表示パネルであり、また、102は走査回路、103は制御回路、104はシフトレジスタ、105はラインメモリ、106は同期信号分離回路、107は変調信号発生器、VxおよびVaは直流電圧源である。

【0073】以下、各部の機能を説明していくが、まず表示パネル101は、端子Dox1ないしDoxm、および端子Doy1ないしDoyN、および高圧端子Hvを介して外部の電気回路と接続している。このうち、端子Dox1ないしDoxmには、前記表示パネル内に設けられている電子源、すなわちM行N列の行列状にマトリクス配線された表面伝導型電子放出素子群を一行（N素子）ずつ順次駆動していく為の走査信号が印加される。

【0074】一方、端子Dy1ないしDyNには、前記走査信号により選択された一行の表面伝導型電子放出素子の各素子の出力電子ビームを制御する為の変調信号が印加される。また、高圧端子Hvには、直流電圧源Vaより、たとえば10K[V]の直流電圧が供給されるが、これは表面伝導型電子放出素子より出力される電子ビームに蛍光体を励起するのに十分なエネルギーを付与する為に加速電圧である。

【0075】次に、走査回路102について説明する。同回路は、内部にM個の各スイッチング素子を備えるもので（図中、S1ないしSmで模式的に示している）、

スイッチング素子は、直流電圧源 V_x の出力電圧もしくは0[V]（グラウンドレベル）のいずれか一方を選択し、表示パネル101の端子 D_{x1} ないし D_{xm} と電気的に接続するものである。S1ないし S_m の各スイッチング素子は、制御回路103が出力する制御信号 T_{scan} に基づいて動作するものだが、実際にはたとえばFETのようなスイッチング素子を組み合わせる事により容易に構成する事が可能である。

【0076】尚、前記直流電圧源 V_x は、本実施態様の場合には前記表面伝導型電子放出素子の特性（電子放出しきい値電圧）に基づき、走査されていない素子に印加される駆動電圧が電子放出しきい値電圧以下となるような一定電圧を出力するよう設定されている。

【0077】また、制御回路103は、外部より入力する画像信号に基づいて適切な表示が行なわれるように各部の動作を整合させる働きをもつものである。次に説明する同期信号分離回路106より送られる同期信号 T_{sync} に基づいて、各部に対して T_{scan} および T_{sft} および T_{mry} の各制御信号を発生する。

【0078】同期信号分離回路106は、外部から入力されるNTSC方式のテレビ信号から、同期信号成分と輝度信号成分とを分離する為の回路で、よく知られているように周波数分離（フィルター）回路を用いれば、容易に構成できるものである。同期信号分離回路106により分離された同期信号は、よく知られるように垂直同期信号と水平同期信号より成るが、ここでは説明の便宜上、 T_{sync} 信号として図示した。一方、前記テレビ信号から分離された画像の輝度信号成分を便宜上DATA信号と表すが、同信号はシフトレジスタ104に入力される。

【0079】シフトレジスタ104は、時系列的にシリアルに入力される前記DATA信号を、画像の1ライン毎にシリアル/パラレル変換するためのもので、前記制御回路103より送られる制御信号 T_{sft} にもとづいて動作する。（すなわち、制御信号 T_{sft} は、シフトレジスタ104のシフトクロックであると言い換えても良い。）シリアル/パラレル変換された画像1ライン分（電子放出素子N素子分の駆動データに相当する）のデータは、 I_{d1} ないし I_{dn} のN個の並列信号として前記シフトレジスタ104より出力される。

【0080】ラインメモリ105は、画像1ライン分のデータを必要時間の間だけ記憶する為の記憶装置であり、制御回路103より送られる制御信号 T_{mry} にしたがって適宜 I_{d1} ないし I_{dn} の内容を記憶する。記憶された内容は、 I'_{d1} ないし I'_{dn} として出力され、変調信号発生器107に入力される。

【0081】変調信号発生器107は、前記画像データ I'_{d1} ないし I'_{dn} の各々に応じて、表面伝導型電子放出素子の各々を適切に駆動変調する為の信号源で、その出力信号は、端子 D_{o1} ないし D_{on} を通じて

表示パネル101内の表面伝導型電子放出素子に印加される。

【0082】前述したように本発明に関わる電子放出素子は放出電流 I_e に対して以下の基本特性を有している。すなわち、前述したように、電子放出には明確なしきい値電圧 V_{th} があり、 V_{th} 以上の電圧を印加された時のみ電子放出が生じる。

【0083】また、電子放出しきい値以上の電圧に対しては、素子への印加電圧の変化に応じて放出電流も変化していく。尚、電子放出素子の材料や構成、製造方法を変える事により、電子放出しきい値電圧 V_{th} の値や、印加電圧に対する放出電流の変化の度合いが変わる場合もあるが、いずれにしても以下のような事がいえる。すなわち、本素子にパルス状の電圧を印加する場合、例えば電子放出閾値以下の電圧を印加しても電子放出は生じないが、電子放出閾値以上の電圧を印加する場合には電子ビームが出力される。その際、第一には、パルスの波高値 V_m を変化させる事により出力電子ビームの強度を制御する事が可能である。第二には、パルスの幅 P_w を変化させる事により出力される電子ビームの電荷の総量を制御する事が可能である。

【0084】従って、入力信号に応じて、電子放出素子を変調する方式としては、電圧変調方式、パルス幅変調方式等があげられ、電圧変調方式を実施するには、変調信号発生器107としては、一定の長さの電圧パルスを発生するが入力されるデータに応じて適宜パルスの波高値を変調するような電圧変調方式の回路を用いる。

【0085】また、パルス幅変調方式を実施するには、変調信号発生器107としては、一定の波高値の電圧パルスを発生するが入力されるデータに応じて適宜電圧パルスの幅を変調するようなパルス幅変調方式の回路を用いるものである。

【0086】以上に説明した一連の動作により、表示パネル101を用いてテレビジョンの表示を行なえる。尚、上記説明中、特に記載しなかったが、シフトレジスタ104やラインメモリ105は、デジタル信号式のものでもアナログ信号式のものでも差し支えなく、要は画像信号のシリアル/パラレル変換や記憶が所定の速度で行なわれればよい。

【0087】デジタル信号式を用いる場合には、同期信号分離回路106の出力信号DATAをデジタル信号化する必要があるが、これは106の出力部にA/D変換器を備えれば容易に可能であることは言うまでもない。また、これと関連してラインメモリ105の出力信号がデジタル信号かアナログ信号かにより、変調信号発生器107に用いられる回路が若干異なったものとなるのは言うまでもない。すなわち、デジタル信号の場合には、電圧変調方式の場合、変調信号発生器107には、たとえばよく知られるD/A変換回路を用い、必要に応じて増幅回路などを付け加えればよい。またパルス幅変調方

式の場合、変調信号発生器107は、たとえば、高速の発振器および発振器の出力する波数を計数する計数器（カウンタ）および計数器の出力値と前記メモリの出力値を比較する比較器（コンパレータ）を組み合わせた回路を用いれば当業者であれば容易に構成できる。必要に応じて、比較器の出力するパルス幅変調された変調信号を表面伝導型電子放出素子の駆動電圧にまで電圧増幅するための増幅器を付け加えてもよい。

【0088】一方、アナログ信号の場合には、電圧変調方式の場合、変調信号発生器107には、たとえばよく知られるオペアンプなどを用いた増幅回路を用いればよく、必要に応じてレベルシフト回路などを付け加えてもよい。また、パルス幅変調方式の場合には、たとえばよく知られた電圧制御型発振回路（VCO）を用いればよく、必要に応じて表面伝導型電子放出素子の駆動電圧にまで電圧増幅するための増幅器を付け加えてもよい。

【0089】以上のように完成した本発明に好適な画像表示装置において、こうして各電子放出素子には、容器外端子 $D \times 1$ ないし $D \times m$ 、 $D \times 1$ ないし $D \times n$ を通じ、電圧を印加することにより電子放出させ、高圧端子 Hv を通じ、メタルバック85、あるいは透明電極（不図示）に高圧を印加し、電子ビームを加速し、蛍光膜84に衝突させ、励起・発光させることで画像を表示することができる。以上述べた構成は、表示等に用いられる好適な画像形成装置を作製する上で必要な概略構成であり、例えば各部材の材料等、詳細な部分は上述内容に限られるものではなく、画像形成装置の用途に適するよう適宜選択する。また、入力信号例として、NTSC方式をあげたが、これに限るものでなく、PAL、SECAM方式などの諸方式でもよく、また、これよりも、多数の走査線からなるTV信号（例えば、MUSE方式をはじめとする高品位TV）方式でもよい。

【0090】次に、前述のはしご型配置の電子源及び画像形成装置について図11、図12を用いて説明する。

【0091】図11において、110は電子源基板、111は電子放出素子、112は $D \times 1 \sim D \times 10$ は、前記電子放出素子を配線するための共通配線である。電子放出素子111は、基板110上に、X方向に並列に複数個配置される。（これを素子行と呼ぶ）。この素子行が複数個配置され、電子源となる。各素子行の共通配線間に適宜駆動電圧を印加することで、各素子行を独立に駆動することが、可能である。すなわち、電子ビームを放出したい素子行には、電子放出しきい値以上の電圧を、電子ビームを放出しない素子行には、電子放出しきい値以下の電圧を印加すればよい。また、各素子行間の共通配線 $D \times 2 \sim D \times 9$ を、例えば $D \times 2$ 、 $D \times 3$ を同一配線とする様にしても良い。

【0092】図12は、はしご型配置の電子源を備えた画像形成装置の表示パネル構造を示すための図である。120はグリッド電極、121は電子が通過するための

空孔、122は $D \times 1$ 、 $D \times 2 \dots D \times m$ よりなる容器外端子、123はグリッド電極120と接続された $G1$ 、 $G2 \dots Gn$ からなる容器外端子、124は前述の様に、各素子行間の共通配線を同一配線とした電子源基板である。尚、図8、11と同一の符号は、同一のものを示す。前述の単純マトリクス配置の画像形成装置（図8に示した）との大きな違いは、電子源基板110とフェースプレート86の間にグリッド電極120を備えている事である。

【0093】基板110とフェースプレート86の間には、グリッド電極120が設けられている。グリッド電極120は、表面伝導型放出素子から放出された電子ビームを変調することができるもので、はしご型配置の素子行と直交して設けられたストライプ状の電極に電子ビームを通過させるため、各素子に対応して1個ずつ円形の開口121が設けられている。グリッドの形状や設置位置は必ずしも図12のようなものでなくてもよく、開口としてメッシュ状に多数の通過口を設けることもあり、またたとえば表面伝導型放出素子の周囲や近傍に設けてもよい。

【0094】容器外端子122およびグリッド容器外端子123は、不図示の制御回路と電気的に接続されている。

【0095】本画像形成装置では、素子行を1列ずつ順次駆動（走査）していくのと同期してグリッド電極列に画像1ライン分の変調信号を同時に印加することにより、各電子ビームの蛍光体への照射を制御し、画像を1ラインずつ表示することができる。

【0096】また、本発明の思想によれば、テレビジョン放送の表示装置のみならず、テレビ会議システム、コンピュータ等の表示装置として、好適な画像形成装置が提供される。さらには、感光性ドラム等とて構成された光プリンターとしての画像形成装置としても用いることもできる。

【0097】

【実施例】以下に本発明の実施例を示す。

実施例1

電子放出素子として図1に示すタイプの電子放出素子を作成した。図1(a)は本素子の平面図を、図1(b)は断面図を示している。また、図1(a)、(b)中の記号1は絶縁性基板、2および3は素子に電圧を印加するための一対の素子電極、4は電子放出部を含む薄膜、5は電子放出部を示す。なお、図中のLは素子電極2と素子電極3の素子電極間隔、Wは素子電極の幅、dは素子電極の厚さ、W'は素子の幅を表している。

【0098】図3を用いて、本実施例の電子放出素子の作成方法を述べる。絶縁性基板1として石英ガラス基板を用い、これを有機溶剤により充分に洗浄後、基板面上にスクリーン印刷法によりAu素子電極2、3を形成した（図3の(a)）。素子電極間隔Lは30ミクロンと

し、素子電極の幅Wを500ミクロン、その厚さdを1000オングストロームとした。

【0099】水にメチルセルロースを加え、溶液粘度5センチボイズに調整したものを、バブルジェット方式のインクジェット装置によって電極2、3の一部に付与した(図3の(b))後基板を150℃で15分加熱した。その後再び基板を室温まで冷却した。

【0100】ジメチルスルホキシド40重量%の水溶液を調製し、これに酢酸パラジウムをパラジウム重量濃度0.4%となるように溶解して暗赤色の溶液を得た。この液の一部を別容器にとり減圧して赤褐色のペーストとなるまで溶媒を蒸発させた。上記の暗赤色溶液の液滴をバブルジェット方式のインクジェット装置によって電極2、3を形成した石英基板の上に電極2、3にまたがるように付与し、80℃で2分乾燥させた。複数の素子について液滴付与を行った結果、いずれにおいても付与された液滴は電極に浸透することなく、再現性良く液滴を付与することができた。次に350℃で12分焼成して無機微粒子膜4を形成した(図3(c))。この電子放出部形成用薄膜4の膜厚は平均100オングストローム、シート抵抗は $5 \times 10^4 \Omega/\square$ であった。

【0101】次に、真空容器中で素子電極2および3の間に電圧を印加し、電子放出部形成用薄膜4を通电処理(フォーミング処理)することにより、電子放出部5を作成した(図3(d))。フォーミング処理の電圧波形を図4に示す。

【0102】本実施例では電圧波形のパルス幅T1を1ミリ秒、パルス間隔T2を10ミリ秒とし、三角波の高値(フォーミング時のピーク電圧)は5Vとし、フォーミング処理は約 1×10^{-6} torrの真空雰囲気下で60秒間行った。このように作成された電子放出部5は、パラジウム元素を主成分とする微粒子が分散配置された状態となった。

【0103】以上のようにして100素子を作成したところ、微粒子の平均粒径はいずれも50オングストロームであった。また微粒子膜21の膜厚のばらつきは、比較例1の80%であった。さらに各々の素子について電子放出特性を図5の構成の測定評価装置により測定した。

【0104】本電子放出素子およびアノード電極54は真空装置内に配置されており、その真空装置には不図示の排気ポンプおよび真空計等の真空装置に必要な機器が具備されており、所望の真空下で本素子の測定評価を行えるようになっている。なお本実施例では、アノード電極と電子放出素子間の距離を4mm、アノード電極の電位を1kV、電子放出特性測定時の真空装置内の真空度を 1×10^{-6} torrとした。

【0105】以上のような測定評価装置を用いて、本電子放出素子100素子について電極2および3の間に素子電圧を印加し、その時に流れる素子電流I_fおよび放

出電流I_eを測定したところ、いずれも図6に示したような電流-電圧特性が得られた。素子電圧12Vにおける放出電流I_eを測定した結果平均0.2μA、電子放出効率は平均0.05%を得た。また素子間の均一性もよく、素子間でのI_eのばらつきは5%と良好な値が得られた。

【0106】以上説明した実施例中、電子放出部を形成する際に、素子の電極間に三角波パルスを印加してフォーミング処理を行っているが、素子の電極間に印加する波形は三角波に限定することなく、矩形波など所望の波形を用いても良く、その波高値およびパルス幅・パルス間隔等についても上述の値に限ることなく、電子放出部が良好に形成されれば所望の値を選択することができる。

実施例2

水にポリビニルアルコールを加え、溶液粘度5センチボイズに調整したものをバブルジェット方式のインクジェット装置により電極の一部に付与し100℃で10分加熱後室温まで冷却した。その後実施例1と同様にして電子放出素子を100素子作成した。微粒子膜の膜厚のばらつきは比較例1の90%であった。さらに実施例1に示した測定評価装置を用いて本電子放出素子の電極2および3の間に素子電圧を印加したところ、素子電圧12Vにおける電子放出は平均0.2μA、電子放出効率は平均0.05%を得た。また素子間のI_eのばらつきは6%であった。

実施例3

16行16列の256個の素子電極とマトリクス状配線とを形成した基板(図7)の各対向電極に対してそれぞれ実施例1と同様にしてメチルセルロースを含む水溶液を付与、加熱、再冷却後、有機金属化合物溶液液滴をバブルジェット方式のインクジェット装置により付与し、焼成したのち、フォーミング処理を行い電子源基板とした。

【0107】この電子源基板にリアプレート81、支持枠82、フェースプレート86を接続し真空封止して図8の概念図に従う画像形成装置を作成した。端子D_{ox}1ないしD_{ox}16と端子D_{oy}1ないしD_{oy}16を通じて各素子に時分割で所定電圧を印加し端子H_vを通じてメタルバックに高電圧を印加することによって、任意のマトリクス画像パターンを表示することができた。

比較例1

絶縁性基板として石英ガラス基板を用い、これを有機溶剤により洗浄後、基板面上にオフセット印刷法によりAu素子電極を形成した。素子電極間隔、幅、厚さは実施例1に示した素子と同様である。

【0108】ジメチルスルホキシド40重量%の水溶液を調製し、これに酢酸パラジウムをパラジウム重量濃度0.4%となるように溶解して暗赤色の溶液を得た。この液の一部を別容器にとり減圧して赤褐色のペーストと

なるまで溶媒を蒸発させた。上記の暗赤色溶液の液滴をバブルジェット方式のインクジェット装置によって電極を形成した石英基板の上に電極にまたがるように付与し、80℃で2分乾燥させた。次に350℃で12分焼成して無機微粒子膜4を形成した。複数の素子について液滴付与を行ったところ、一部の素子において液滴が電極内に浸透するという現象が発生し、これらの素子においては他の素子よりも焼成後の膜厚が薄くなった。素子間の膜厚のばらつきは実施例1〜3に比べ大きかった。

【0109】その後、実施例1と同様の方法でフォーミング処理を行なった。

【0110】以上のようにして100素子を作製し、各々の素子について電子放出特性を図5の構成の測定評価装置により測定した。その結果、素子電圧12Vにおける放出電流は平均0.2 μ A、電子放出効率率は平均0.05%を得た。また素子間の I_e のばらつきは実施例1〜3の場合よりも大きくなった。

【0111】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の方法に従い電子放出素子を作製するならば、有機金属化合物を含む水溶液の電極内への浸透を防ぐことが可能となり、得られる電子放出膜の膜厚や素子特性のばらつきの少ない電子放出素子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に好適な基本的な表面伝導型電子放出素子の構成を示す模式的平面図及び断面図

【図2】 本発明に好適な基本的な垂直型表面伝導型電子放出素子の構成を示す模式的図

【図3】 本発明に好適な表面伝導型電子放出素子の製造方法の1例

【図4】 本発明に好適な通電フォーミングの電圧波形の例

【図5】 電子放出特性を測定するための測定評価装置の概略構成図

【図6】 本発明に好適な表面伝導型電子放出素子の放出電流 I_e および素子電流 I_f と素子電圧 V_f の関係の

典型的な例

【図7】 単純マトリクス配置の電子源

【図8】 画像形成装置の表示パネルの概略構成図

【図9】 蛍光膜

【図10】 画像形成装置をNTSC方式のテレビ信号に応じて表示を行う例の駆動回路のブロック図

【図11】 梯子配置の電子源

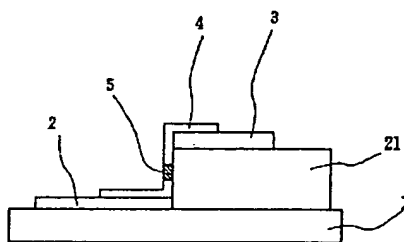
【図12】 画像形成装置の表示パネルの概略構成図

【図13】 従来の電子放出素子の模式図

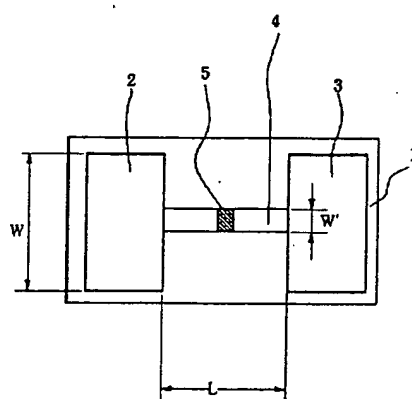
【符号の説明】

1：基板、2、3：素子電極、4：導電性薄膜、5：電子放出部、21：段差形成部、50：素子電極2、3間の導電性薄膜4を流れる素子電流 I_f を測定するための電流計、51：電子放出素子に素子電圧 V_f を印加するための電源、53：アノード電極54に電圧を印加するための高圧電源、54：素子の電子放出部より放出される放出電流 I_e を捕捉するためのアノード電極、55：素子の電子放出部5より放出される放出電流 I_e を測定するための電流計、56：真空装置、57：排気ポンプ、71：電子源基板、72：X方向配線、73：Y方向配線、74：表面伝導型電子放出素子、75：結線、81：リアプレート、82：支持枠、83：ガラス基板、84：蛍光膜、85：メタルバック、86：フェースプレート、87：高圧端子、88：外周器、91：黒色導電材、92：蛍光体、93：ガラス基板、101：表示パネル、102：走査回路、103：制御回路、104：シフトレジスタ、105：ラインメモリ、106：同期信号分離回路、107：変調信号発生器、 V_x および V_a ：直流電圧源、110：電子源基板、111：電子放出素子、112： $D \times 1 \sim D \times 10$ は、前記電子放出素子を配線するための共通配線、120：グリッド電極、121：電子が通過するための空孔、122： $D \times 1$ 、 $D \times 2 \dots D \times m$ よりなる容器外端子、123：グリッド電極120と接続された G_1 、 $G_2 \dots G_n$ からなる容器外端子、124：電子源基板。

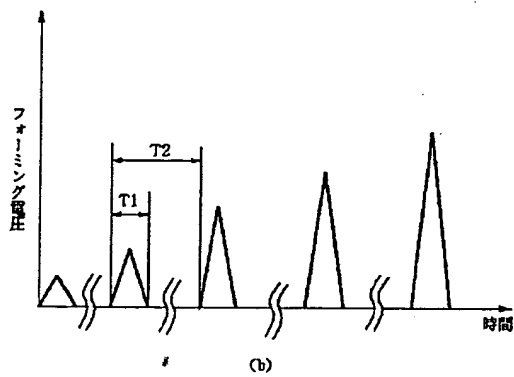
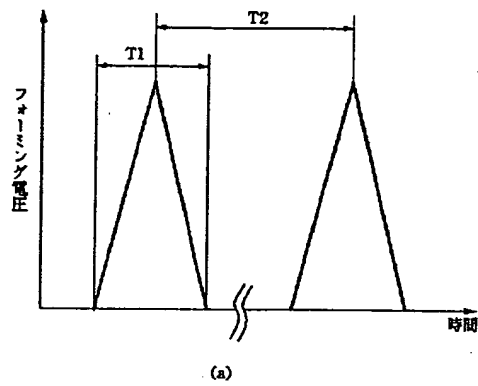
【図2】



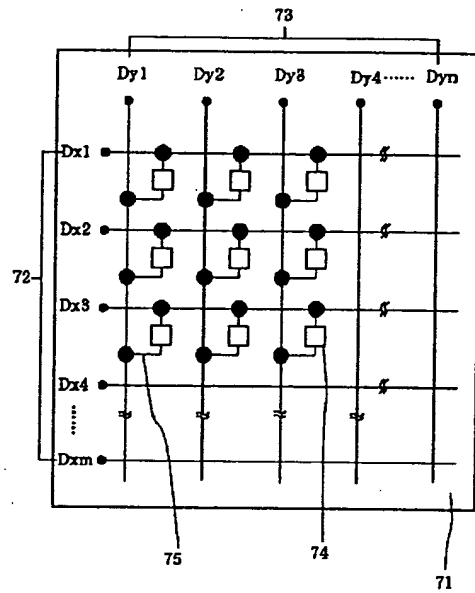
【図13】



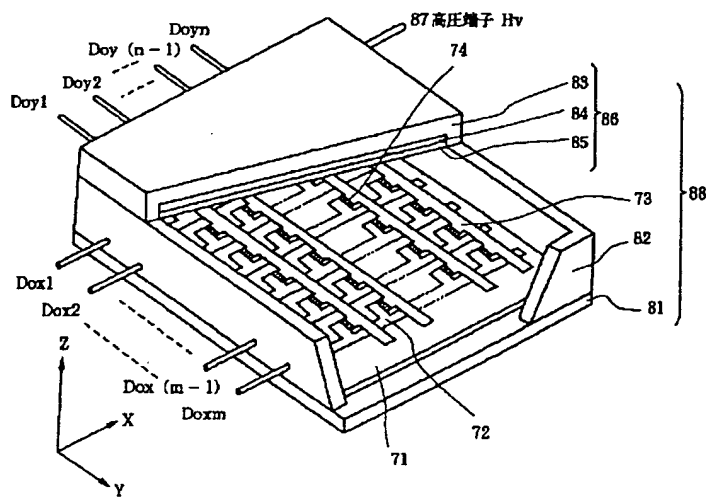
【図4】



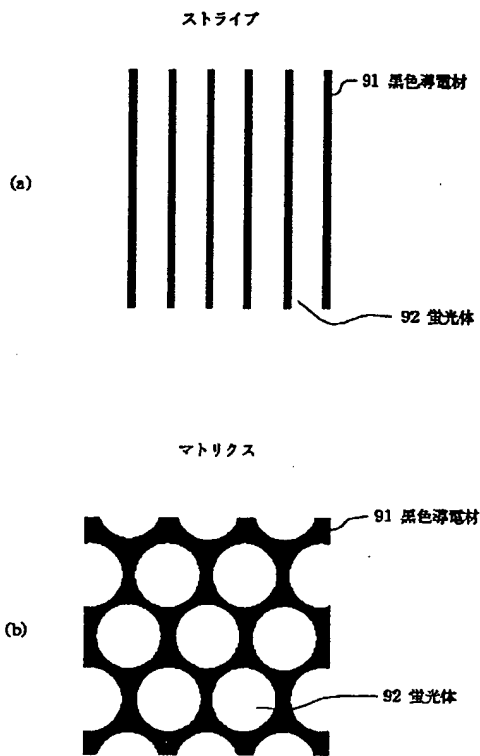
【図7】



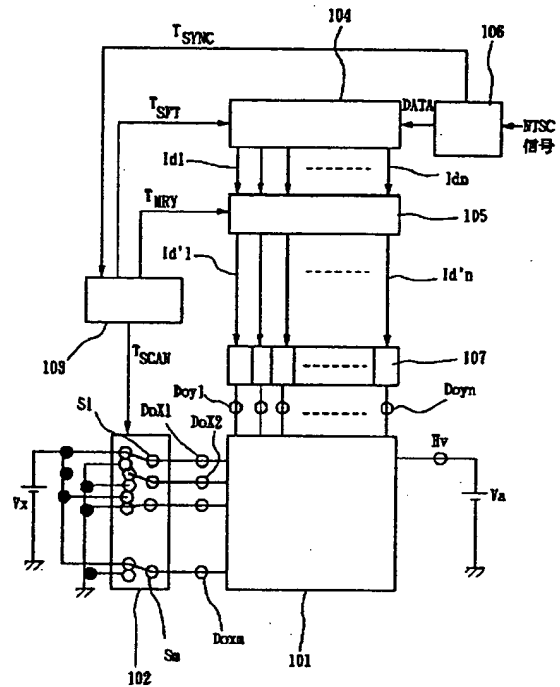
【図8】



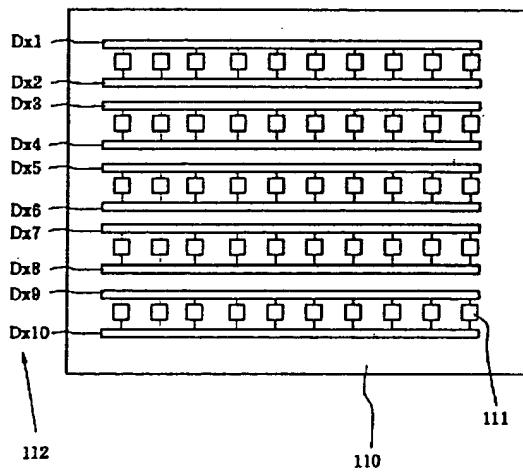
【図9】



【図10】



【図11】



【図12】

